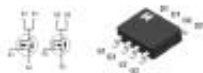


Link do produktu: <https://sklep.barth.pl/emb28c03-28c03-2803-p-189.html>

EMB28C03, 28C03, 2803

Cena brutto	10,00 zł
Cena netto	8,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

EMB28C03G (B28C03) – Komplementarna para tranzystorów MOSFET N-Channel + P-Channel Logic Level, SOP-8

Opis produktu

EMB28C03G, oznaczany również kodem **B28C03**, to wysokiej jakości komplementarna para tranzystorów MOSFET typu **N-Channel oraz P-Channel** zamknięta w jednej kompaktowej obudowie **SOP-8**. Układ został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych urządzeniach elektronicznych wymagających niewielkich wymiarów, wysokiej sprawności oraz bezpośredniego sterowania z mikrokontrolerów pracujących z napięciem **3,3 V lub 5 V**.

Połączenie tranzystora N-MOS oraz P-MOS w jednym układzie pozwala znacznie uprościć projektowanie urządzeń elektronicznych. EMB28C03G doskonale sprawdza się jako element mostków H, przełączników zasilania, układów ładowania akumulatorów, sterowników silników, przetwornic DC/DC oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie i energooszczędne przełączanie napięcia dodatniego i ujemnego.

Dzięki bardzo niskiej rezystancji kanału tranzystory charakteryzują się niewielkimi stratami mocy oraz małym nagrzewaniem podczas pracy. Układ może przewodzić prąd do **7 A** dla tranzystora N-Channel oraz **6 A** dla tranzystora P-Channel, przy maksymalnym napięciu pracy odpowiednio **30 V** i **-30 V**.

Najważniejsze zalety

- komplementarna para tranzystorów **N-MOS + P-MOS** w jednej obudowie,
- sterowanie **Logic Level** – współpraca z mikrokontrolerami 3,3 V i 5 V,
- niewielka rezystancja przewodzenia ograniczająca straty mocy,
- szybkie przełączanie dzięki małemu ładunkowi bramki,
- niewielkie rozmiary obudowy SOP-8,
- element zgodny z RoHS – bezołowiowy i bezhalogenowy,
- idealny do projektów profesjonalnych oraz hobbystycznych.

Parametry techniczne

Tranzystor N-Channel

- napięcie dren-źródło (VDS): **30 V**
- prąd ciągły (ID): **7 A**
- rezystancja RDS(on): **28 mΩ (maks.)**

Tranzystor P-Channel

- napięcie dren-źródło (VDS): **-30 V**
- prąd ciągły (ID): **-6 A**

- rezystancja RDS(on): **45 mΩ (maks.)**

Pozostałe parametry

- typ: MOSFET Enhancement Mode
- napięcie bramka-źródło: **±20 V**
- obudowa: **SOP-8**
- zakres temperatur pracy: **−55°C do +150°C**
- technologia Logic Level
- montaż SMD.

Typowe zastosowania

EMB28C03G znajduje zastosowanie między innymi w:

- mostkach H do sterowania silnikami DC,
- elektronicznych przełącznikach zasilania,
- przetwornicach impulsowych DC/DC,
- sterownikach pomp, elektrozaworów i wentylatorów,
- ładowarkach oraz układach zarządzania akumulatorami,
- urządzeniach IoT,
- automatyce przemysłowej,
- sterownikach LED,
- zasilaczach impulsowych,
- urządzeniach opartych o Arduino, ESP32, STM32, AVR, PIC i inne mikrokontrolery.

Dlaczego warto wybrać EMB28C03G?

Zastosowanie komplementarnej pary MOSFET-ów w jednej obudowie pozwala ograniczyć liczbę elementów na płytce PCB, zmniejszyć koszty produkcji oraz uprościć projektowanie układów elektronicznych. Dzięki niewielkiej rezystancji kanału i możliwości bezpośredniego sterowania z mikrokontrolerów układ zapewnia wysoką sprawność, szybkie przełączanie i dużą niezawodność.

EMB28C03G jest doskonałym wyborem zarówno dla producentów urządzeń elektronicznych, serwisów, konstruktorów automatyki, jak i hobbystów projektujących własne układy elektroniczne.